

Deutsche  
Demokratische  
Republik

Halbleiterbauelemente  
HALBLEITERDIODEN VERLUSTLEISTUNG UNTER 1 WATT  
Bauformen

TGL

200-8380

Gruppe 13781

Полупроводниковые приборы  
ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ  
Мощность потери меньше 1 ватта

Semiconductor Devices  
DESIGNS FOR SEMICONDUCTOR DIODES  
Dissipation power less 1 Watt

Deskriptoren: Halbleiterbauelement; Halbleiterdiode; Bauform

Verbindlich ab 1.8.1982

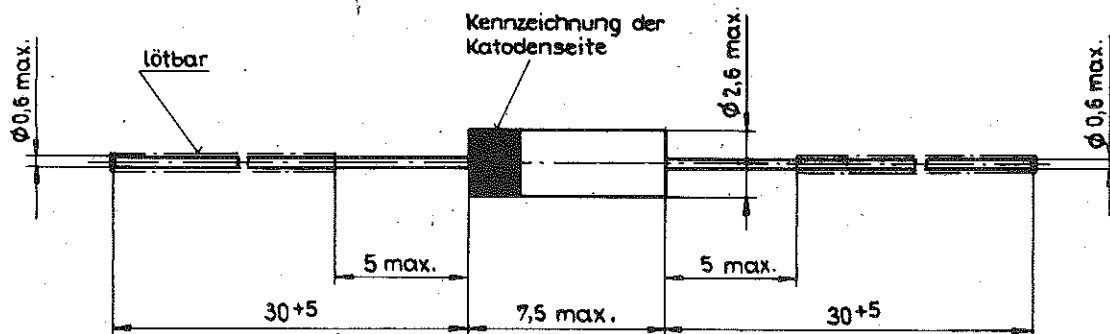
Bauformen B, D und K für Neuentwicklung nicht mehr zugelassen

Eigentum des ITM

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.  
Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe: mittel TGL 2897.

Maße in mm

B



Fortsetzung Seite 2 bis 4

Verantwortlich/  
bestätigt: 2.12.1981, VEB Kombinat Mikroelektronik, Erfurt



M

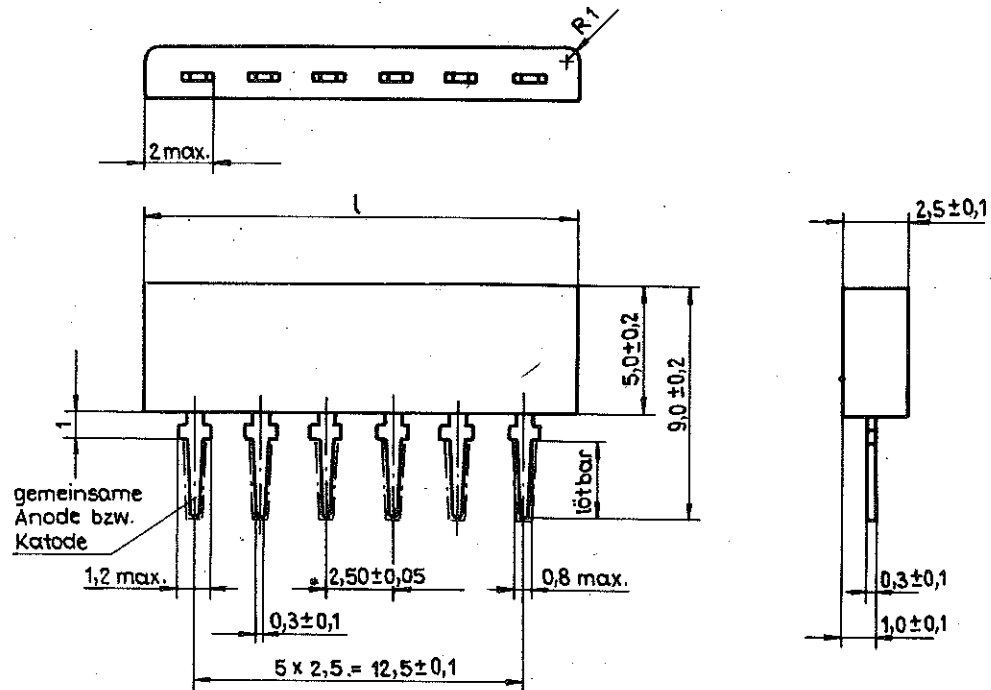
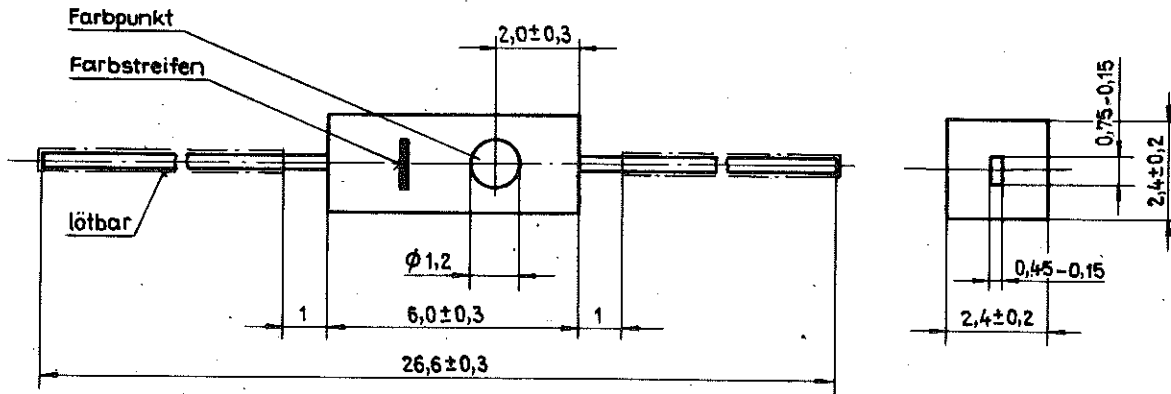


Tabelle 2

Bauform	Länge $l$	Anzahl der Diodenfunktionen	Anzahl der Anschlüsse
M 1	9,0	2	3
M 2	10,1 oder 11,5	3	4
M 3	14,0	4	5
M 4	15,1 oder 16,5	5	6

N



## Hinweise

Ersatz für TGL 200-8380 Ausg. 4.69

Änderungen gegenüber Ausg. 4.69:

Neuaufnahme der Bauformen M und N, Streichung der Bauformen A, C, E, F, G, H, I

Im vorliegenden Standard ist auf folgende Standards Bezug genommen:

TGL 2897

Halbleiterbauelemente; Bauformen für Halbleitergleichrichterdiode siehe TGL 200-8327

Halbleiterbauelemente; Abmessungen und Anschlußmaße siehe ST RGW 1818-79

## Gegenüberstellung der Bauformen

Bauform nach TGL 200-8380	Bauform nach ST RGW 1818-79	Bauform-Abweichung	
		TGL 200-8380	ST RGW 1818-79
B	C 1-3	Anschlußdrahtdurchmesser 0,6 max.	0,56 max.
K	C 1-1	Abstand Verzinnung-Gehäuse 5 max.	2,5 max
L 2	C 64	-	-